



دانشگاه گنبد کاووس

نشریه " تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهان "

دوره اول، شماره اول، پاییز ۹۲

<http://arpe.gonbad.ac.ir>

اثر دما و پتانسیل اسمزی بر جوانه‌زنی بذور گل جالیز مصری (*Orobanche aegyptiaca*)

ابراهیم کازرونی منفرد^۱، سمیه تکاسی^۲، محمد بنایان^۳، علی قنبری^۴،

حمید رحیمیان مشهدی^۵ و پر نیلسن کودسک^۶

استادیار دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان، ^۱دکترای علوم علف‌های هرز، ^۲دانشیار گروه زراعت دانشگاه فردوسی مشهد،

^۳دانشیار گروه زراعت دانشگاه فردوسی مشهد، ^۴استاد گروه زراعت دانشگاه تهران، ^۵استاد دانشگاه آروس دانمارک

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۷/۲۰؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۸/۲۶

چکیده

علف هرز انگل گل جالیز (*Orobanche spp.*)، تهدیدی جدی برای تولید چندین گیاه زراعی در اروپا، آفریقا و آسیا به شمار می‌آید. این پژوهش در پاییز ۱۳۹۰ در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آروس دانمارک برای بررسی اثر درجه حرارت و پتانسیل اسمزی بر جوانه‌زنی بذور گل جالیز مصری (*O. aegyptiaca*) انجام شد. تیمارها شامل شش سطح درجه حرارت (۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰ و ۴۰ درجه سانتی‌گراد) و پنج سطح پتانسیل اسمزی (۰، ۰/۳، ۰/۶، ۰/۹، ۱/۲ و ۱/۴ مگاپاسکال) و یک شاهد که از آب مقطر استفاده شد بودند. آزمایش با آرایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که با کاهش پتانسیل اسمزی، درصد جوانه زنی و دامنه دمایی مطلوب جوانه‌زنی بذور گل جالیز مصری کاهش یافت. به طوری که پتانسیل اسمزی ۱/۲- مگاپاسکال با ۵۷ درصد کمترین درصد جوانه زنی را داشت. همچنین، کاهش پتانسیل اسمزی موجب تأخیر در شروع، متوسط و حداکثر جوانه‌زنی بذور شد. دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد با ۹۴/۲ درصد و دمای ۳۵ درجه سانتی‌گراد با ۲۶/۴ درصد به ترتیب بیشترین و کمترین درصد جوانه‌زنی را داشتند. دمای ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دمای ۱۰ درجه سانتی‌گراد به ترتیب بیشترین و کمترین سرعت جوانه‌زنی را داشتند. دمای حداقل، مطلوب و حداکثر جوانه‌زنی بذور گل جالیز مصری به ترتیب ۵/۶، ۳۰/۱ و ۴۰ درجه سانتی‌گراد بود.

واژه‌های کلیدی: پلی‌اتیلن گلیکول، درجه حرارت کاردینال، درصد جوانه‌زنی، آماده‌سازی بذر، ماده محرک

جوانه‌زنی GR₂₄

*نویسنده مسئول: e_kazerooni@yahoo.com

مقدمه

گل‌جالیز^۱، علف هرز یک‌ساله و انگل اجباری ریشه برخی از گیاهان زراعی دولپه است (Eizenberg *et al.*, 2001). ورنسنو و همکاران (Vranceanu *et al.*, 1986) گزارش کردند که هر ساقه هوایی گل‌جالیز که به خوبی توسعه یافته باشد، حدود ۵۰۰۰۰ بذر تولید می‌کند. مطالعات کبری‌آب و موردوخ (Kebreab and Murdoch, 1999 b and 2000) روی بذرگل‌جالیز نشان داد که دو عامل پتانسیل اسمزی و درجه حرارت بر درصد جوانه‌زنی نهایی بذور تأثیر می‌گذارند. مطالعه اثر درجه حرارت بر جوانه‌زنی بذور گونه‌های *O. aegyptiaca*، *O. crenata* و *O. cumana* نشان داد که گونه‌های گل‌جالیز دامنه درجه حرارت مطلوب متفاوتی برای جوانه‌زنی و توسعه را دارند که می‌تواند بازتابی از توزیع جغرافیایی هر گونه باشد (Sauerborn, 1991). کبری‌آب و موردوخ (Kebreab and Murdoch, 1999 a) گزارش کردند که درجه حرارت بهینه جوانه‌زنی بذور گل‌جالیز مصری، بین ۲۱-۱۸ درجه سانتی‌گراد است. نامبردگان (۲۰۰۰) در بررسی دیگری دریافتند که بیشترین درصد جوانه‌زنی بذور گل‌جالیز مصری در دامنه دمایی ۲۶-۲۰ درجه سانتی‌گراد رخ می‌دهد. باغستانی و همکاران (Baghestani *et al.*, 2010) گزارش کردند که حداکثر درصد جوانه‌زنی بذور گل‌جالیز مصری در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد انجام می‌شود. برادفورد (Bradford, 2002) بیان کرد که فراهم بودن آب، عامل کلیدی در زمان خواب و جوانه‌زنی بذر است. هرگاه پتانسیل اسمزی کمتر از حد بحرانی باشد، بذر با تنش آب روبرو خواهد شد و بسته به شدت کاهش پتانسیل اسمزی، جوانه‌زنی به تأخیر افتاده یا متوقف می‌شود. سرعت جوانه‌زنی بذر از شاخص‌های مهم در ارزیابی تحمل به خشکی در مرحله جوانه‌زنی است. هرچه سرعت جوانه‌زنی بذر بیشتر باشد شانس استقرار تحت شرایط تنش نیز بیشتر خواهد شد (Fernandez and Johnston, 1995). آغاز خروج ریشه‌چه، نسبت به مراحل بعدی رشد گیاهچه، اغلب بیشترین حساسیت را به تنش آب دارد. اگر فرایند جذب آب توسط بذر دچار اختلال گردد، سرعت فعالیت‌های متابولیکی جوانه‌زنی داخل بذر کند شده، در نتیجه مدت زمان خروج ریشه‌چه از بذر افزایش و از این‌رو سرعت جوانه‌زنی کاهش خواهد یافت (Abnous, 2001). قنبری و همکاران (Ghanbari *et al.*, 2005) بیان کردند که دماهای کاردینال بذور شیرین بیان (*Glycyrrhiza glabra* L.) متأثر از شرایط رطوبتی هستند. برای مثال، دمای پایه جوانه‌زنی با کاهش پتانسیل اسمزی افزایش می‌یابد. کبری‌آب و موردوخ (Kebreab and Murdoch, 1999a) گزارش کردند که دمای پایه جوانه‌زنی بذور گل‌جالیز مصری با کاهش پتانسیل اسمزی کاهش یافت. آنها همچنین بیان کردند که بذور گل‌جالیز مصری می‌توانند در دماهای مطلوب در سطوح بالاتری از تنش آبی نیز جوانه بزنند. کبری‌آب و موردوخ (Kebreab and Murdoch, 2000)

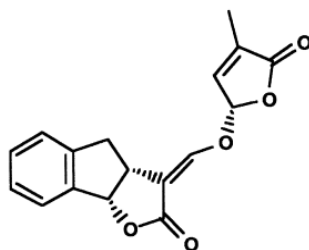
1- *Orobanche* spp.

همچنین بیان کردند که دمای مطلوب حداکثر جوانه‌زنی بذور گل‌جالیز مصری با کاهش پتانسیل اسمزی کاهش می‌یابد. برای مثال، دمای مطلوب جوانه‌زنی در صفر مگاپاسکال ۲۶ درجه سانتی‌گراد بود که در ۱/۲۵ مگاپاسکال به ۲۰ درجه سانتی‌گراد رسید. توانایی پیش‌بینی جوانه‌زنی بذور در دما و پتانسیل‌های اسمزی مختلف در گیاهان زراعی و علف‌های هرز بسیار کاربردی است. در واقع با پیش‌بینی سطح آلودگی می‌توان به طراحی یک برنامه کنترلی مناسب دست یافت. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثر دما و پتانسیل‌های اسمزی مختلف بر صفات جوانه‌زنی بذور گل‌جالیز مصری انجام شد.

مواد و روش‌ها

بذور گل‌جالیز مصری (*Orobanche aegyptiaca*)، در تابستان ۱۳۸۹ از مزرعه گوجه فرنگی استان قدس رضوی مشهد که به‌طور طبیعی دارای درصد آلودگی بالایی از گل‌جالیز مصری بود، جمع‌آوری شدند. بذور جمع‌آوری شده در سایه خشک و تمیز شده و تا زمان استفاده در دمای ۴-۵ درجه سانتی‌گراد و تاریکی نگهداری شدند. این پژوهش در پاییز ۱۳۹۰ در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آروس دانمارک انجام شد. تیمارها شش سطح درجه‌حرارت ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۳۵ و ۴۰ درجه سانتی‌گراد و پنج سطح پتانسیل اسمزی ۰، ۰/۳، ۰/۶، ۰/۹، ۱/۲- مگاپاسکال و یک شاهد که از آب مقطر استفاده شد، را دربر گرفتند. آزمایش با آرایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. در هر پتری دیش ۹ سانتی‌متری، ۲۵ عدد بذر گل‌جالیز مصری روی کاغذ صافی واتمن قرار داده شدند. برای مرطوب کردن کاغذ صافی‌ها در دوره آماده‌سازی از آب مقطر استفاده شد. تمام پتری دیش‌ها درون سینی که کف آن حاوی دستمال کاغذی مرطوب بود، چیده شدند و داخل کیسه پلاستیکی سیاه قرار داده شدند تا تبخیر آب کاهش یافته و شرایط تاریکی برای بذور فراهم شود و به مدت ۶ روز در انکوباتور با دمای ۲۱ درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند. پس از گذراندن دوره آماده‌سازی، بذور خشک شده و به هر پتری دیش ۱۰۰ میکرولیتر (۱۰ پی‌پی‌ام) ماده محرک جوانه‌زنی GR₂₄ (شکل ۱، Johnson et al., 1981)، سپس ۲ میلی‌لیتر محلول پلی‌اتیلن‌گلیکول (MW 6000, Merck) اضافه شد. درب پتری دیش‌ها با پارافیلیم مسدود و در انکوباتورهای تنظیم شده با دماهای مورد آزمایش نگهداری شدند. در زمان جوانه‌زنی نیز تمامی پتری دیش‌ها در پلاستیک‌های سیاه قرار داده شدند تا در شرایط تاریکی قرار گیرند. ۳۶ ساعت پس از شروع آزمایش شمارش بذور جوانه‌زده آغاز شد. خروج ریشه‌چه و قابل رؤیت بودن آن به عنوان معیار جوانه‌زنی در نظر گرفته شد. شمارش جوانه‌زنی بذور هر ۱۲ ساعت یک‌بار زیر بینوکولر انجام می‌شد. بذور جوانه‌دار پس از شمارش

از پتری‌دیش‌ها حذف و شمارش تا زمانی که بذور تا سه روز جوانه نزد (حدود ۱۰ روز پس از شروع آزمایش) انجام شد.



شکل ۱- ساختار شیمیایی ماده محرک جوانه‌زنی GR₂₄ (Johnson et al., 1981)

در تمام تیمارهای دمایی و رطوبتی جوانه‌زنی، برای هر تکرار منحنی جوانه‌زنی تجمعی در مقابل زمان (روز یا ساعت) رسم شد و مدل رگرسیونی ویبول ۴ پارامتری (معادله ۱) به آنها برازش داده شد و زمان لازم برای رسیدن به ۱۰ درصد (D₁₀)، ۵۰ درصد (D₅₀) و ۹۰ درصد (D₉₀) جوانه‌زنی به شیوه درونیابی برآورد شد. از ضرایب این مدل ۳ صفت بیولوژیک به دست آمد که شامل حداکثر درصد جوانه‌زنی، زمان تا ۵۰ درصد جوانه‌زنی و زمان تأخیری جوانه‌زنی می‌باشند. معکوس زمان تا ۵۰ درصد جوانه‌زنی ($\frac{1}{D_{50}}$) به‌عنوان سرعت جوانه‌زنی در نظر گرفته شد (Scott et al., 1984).

$$Y = a \left[1 - e^{-\left[\frac{x-x_0+b \ln 2^{\frac{1}{c}}}{b} \right]^c} \right] \quad \text{معادله (۱)}$$

Y: درصد جوانه‌زنی تجمعی، a: حداکثر درصد جوانه‌زنی، X₀: زمان تا ۵۰ درصد جوانه‌زنی، X: زمان (روز یا ساعت) و b و c: ضرایب ثابت مدل می‌باشند.

یکنواختی جوانه‌زنی (GU)، اختلاف زمان بین ۱۰ (D₁₀) و ۹۰ (D₉₀) درصد جوانه‌زنی می‌باشد (GU=D₉₀-D₁₀) که هر چقدر عدد آن کمتر باشد، یکنواختی جوانه‌زنی بیشتر است؛ یعنی فاصله بین زمان تا ۱۰ و ۹۰ درصد جوانه‌زنی کمتر می‌باشد.

برای تعیین دماهای کاردینال، روند صفات جوانه‌زنی در تیمارهای مختلف از مدل رگرسیونی خطی متقاطع (ISL)^۱، چند جمله‌ای درجه ۲ (QPN)^۲ و دندانه مانند (DL)^۳ به ترتیب با معادله‌های ۲، ۳ و ۴

- 1- Intersected-lines Model
- 2- Quadratic Polynomial Model
- 3- Dent-Like

به داده‌های سرعت جوانه‌زنی در دماهای مختلف برازش داده شد (Soltani *et al.*, 2006; Behdani *et al.*, 2008).

$$f(T) = b \times (T - T_b) \text{ if } T \leq T_o \quad \text{معادله (۲)}$$

$$f(T) = c \times (T_c - T) \text{ if } T \geq T_o$$

$$f(T) = a + bT - cT^2 \quad \text{معادله (۳)}$$

$$f(T) = \frac{(T - T_b)}{(T_{o1} - T_b)} \quad \text{if } T_b < T < T_{o1} \quad \text{معادله (۴)}$$

$$f(T) = \frac{(T_c - T)}{(T_c - T_{o2})} \quad \text{if } T_{o2} < T < T_c$$

$$f(T) = 1 \quad \text{if } T_{o1} < T < T_{o2}$$

$$f(T) = 0 \quad \text{if } T \leq T_b \text{ or } T \geq T_c$$

(T)F

صفت جوانه زنی (سرعت)، T دما (درجه سانتی‌گراد)، T_b ، T_o و T_c به ترتیب دماهای کمینه، بهینه و بیشینه، T_{o1} و T_{o2} به ترتیب دمای بهینه اول (پایین) و بهینه دوم (بالا) به دست آمده از مدل دندانده مانند، a، b، c، ضرایب مدل می‌باشند. برای نرمال‌سازی، تبدیل زاویه‌ای (Arc sinx) داده‌های درصد جوانه‌زنی انجام شد. تجزیه داده‌ها با نرم‌افزار SAS ver. 9.1 انجام گرفت و مقایسه میانگین تیمارها با آزمون LSD در سطح یک درصد و برازش مدل با نرم افزار Sigmaplot 11.0 انجام شد.

نتایج و بحث

درصد جوانه‌زنی تجمعی: بررسی روند درصد جوانه‌زنی تجمعی بذور در پتانسیل‌های اسمزی مورد بررسی در دمای ۱۰ درجه سانتی‌گراد (شکل ۲ الف) نشان داد که فاز تأخیری جوانه‌زنی بذور ۲۰۰ ساعت بود که با کاهش پتانسیل اسمزی، فاز تأخیری جوانه‌زنی طولانی‌تر شد. زمان تا ۵۰ درصد جوانه‌زنی و حداکثر درصد جوانه‌زنی برآورد شده در پتانسیل‌های اسمزی ۰ تا ۱/۲- مگاپاسکال به ترتیب ۲۴۱، ۲۴۶، ۲۵۳، ۲۵۴/۴ ساعت و ۸۱/۶، ۷۰/۶، ۵۲/۸، ۳۲ و ۶ درصد بود، به طوری که با کاهش پتانسیل اسمزی، زمان تا ۵۰ درصد جوانه‌زنی افزایش و حداکثر درصد جوانه‌زنی کاهش یافت (شکل ۲ الف). در دمای ۱۵ درجه سانتی‌گراد، شروع جوانه‌زنی ۱۰۰ ساعت بود که با کاهش پتانسیل اسمزی درصد جوانه‌زنی نهایی، کاهش و زمان تا ۵۰ درصد جوانه‌زنی، افزایش یافت. حداکثر درصد جوانه‌زنی برآورد شده در این دما در پتانسیل‌های اسمزی مورد بررسی به ترتیب ۹۵/۸، ۸۸، ۸۸/۷، ۸۴/۹ و ۶۶/۲ درصد بود. حداکثر درصد جوانه‌زنی برآورد شده در دمای مذکور در همه پتانسیل‌های اسمزی از دمای ۱۰ درجه سانتی‌گراد بیشتر و زمان تا ۵۰ درصد جوانه‌زنی کمتر بود (شکل ۲ ب). در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد، حداکثر درصد جوانه‌زنی برآورد شده در پتانسیل‌های اسمزی مختلف از دو دمای قبلی بیشتر و زمان تا

۵۰ درصد جوانه‌زنی کمتری داشت. در این دما نیز با کاهش پتانسیل اسمزی، درصد جوانه‌زنی کاهش و زمان تا ۵۰ درصد افزایش یافت. حداکثر درصد جوانه‌زنی برآورد شده در پتانسیل‌های اسمزی مورد بررسی به ترتیب ۹۸/۹، ۹۵/۴، ۹۲/۳، ۹۰/۲ و ۹۰/۹ درصد بود. اختلاف حداقل و حداکثر درصد جوانه‌زنی پتانسیل اسمزی صفر و ۱/۲- مگاپاسکال حدود ۸ درصد بود، در حالی که این اختلاف برای دمای ۱۰ و ۱۵ به ترتیب ۷۵/۶ و ۲۹/۶ درصد بود. می‌توان بیان کرد با افزایش دما تا دمای بهینه برای جوانه‌زنی اثر پتانسیل اسمزی کاهش و درصد جوانه‌زنی در پتانسیل‌های اسمزی بالا کاهش معنی‌داری نداشت (شکل ۲ ج). شروع جوانه‌زنی در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد در همه پتانسیل‌های اسمزی ۵۰ ساعت بعد از شروع آزمایش بود؛ ولی زمان تا ۵۰ درصد جوانه‌زنی و حداکثر جوانه‌زنی در پتانسیل‌های اسمزی مختلف متفاوت بود که روند تغییرات همانند ۳ دمای پیشین بود. به بیان دیگر، کاهش پتانسیل اسمزی موجب کاهش حداکثر درصد جوانه‌زنی برآورد شده و افزایش زمان تا ۵۰ درصد جوانه‌زنی شد. حداکثر درصد جوانه‌زنی در پتانسیل‌های اسمزی صفر تا ۱/۲- مگاپاسکال به ترتیب ۹۸، ۹۷/۹، ۹۷/۶، ۹۲ و ۸۱/۷ درصد و زمان تا ۵۰ درصد جوانه‌زنی نیز به ترتیب ۴۸/۲، ۴۸/۶، ۴۹/۲، ۵۹/۶ و ۷۳/۷ ساعت بود (شکل ۲ د). در دمای ۳۰ درجه سانتی‌گراد، کمترین زمان تا ۵۰ درصد جوانه‌زنی در همه پتانسیل‌های اسمزی مشاهده شد. در این دما نیز با کاهش پتانسیل اسمزی زمان تا ۵۰ درصد جوانه‌زنی افزایش یافت. حداکثر درصد جوانه‌زنی برآورد شده در دمای ۳۰ درجه سانتی‌گراد تا حدودی افزایش یافت که در پتانسیل‌های اسمزی صفر تا ۱/۲- مگاپاسکال به ترتیب ۹۶/۱، ۹۲/۸، ۹۳/۳، ۹۱/۸ و ۹۱/۸ درصد بود. در این دما، حداکثر درصد جوانه‌زنی برآورد شده روندی مشابه دیگر دماها داشت؛ اما حداکثر جوانه‌زنی از شاهد تا پتانسیل اسمزی ۰/۹- مگاپاسکال از دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد کمتر بود. در پتانسیل اسمزی ۱/۲- مگاپاسکال ۱۰ درصد افزایش نسبت به دمای مذکور مشاهده شد (شکل ۲). در این دما، شروع جوانه‌زنی در همه پتانسیل‌های اسمزی ۳۶ ساعت بعد از آغاز آزمایش بود که در پتانسیل‌های اسمزی صفر تا ۰/۶- مگاپاسکال در ساعت ۶۰ آزمایش و در پتانسیل اسمزی ۰/۹- و ۱/۲- مگاپاسکال در حدود ۷۰ ساعت پس از شروع آزمایش به حداکثر جوانه‌زنی خود رسید. در دمای ۳۰ درجه سانتی‌گراد اختلاف زمان بین شروع تا حداکثر جوانه‌زنی در همه پتانسیل‌های اسمزی از دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد کمتر بود. در دمای ۳۵ درجه سانتی‌گراد، در همه پتانسیل‌های اسمزی مجدداً افزایش زمان تا ۵۰ درصد جوانه‌زنی مشاهده شد که با کاهش پتانسیل اسمزی روند آن افزایشی بود. حداکثر درصد جوانه‌زنی دارای روند کاهشی خیلی شدید بود. به‌طوری‌که حداکثر درصد جوانه‌زنی در پتانسیل اسمزی صفر تا ۱/۲- مگاپاسکال به ترتیب ۵۲/۹، ۲۸/۹، ۱۸/۱، ۲۵ و ۷ درصد بود و حداکثر اختلاف کمترین و بیشترین درصد جوانه‌زنی برآورد شده در یک دما را بعد از دمای ۱۰، دمای ۳۵ درجه سانتی‌گراد داشت (شکل ۲). در دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد نیز جوانه‌زنی در بذور گل‌جالیز مصری مشاهده نشد. در مجموع، با افزایش دما تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد زمان تا ۵۰ درصد جوانه‌زنی در همه پتانسیل‌های اسمزی کاهش و بعد از آن دوباره افزایش یافت. حداکثر درصد جوانه‌زنی

برآورد شده در دماهای ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد رخ داد. هر چه فاصله از محدوده دمای مطلوب بیشتر شد، روند کاهشی درصد جوانه زنی با کاهش پتانسیل اسمزی شدیدتر شد. (Kebreab and (1999 a) Murdoch گزارش کردند که بذره‌های گل جالیز مصری قادرند در دماهای مطلوب در سطوح بالاتری از تنش آب نیز درصد جوانه زنی بالایی داشته باشند.

درصد جوانه زنی نهایی: اثر دما، پتانسیل اسمزی و برهم کنش آنها بر درصد جوانه زنی نهایی بذور معنی دار بود (جدول ۱).

جدول ۱- تجزیه واریانس اثر دمای آماده سازی، زمان آماده سازی و دمای جوانه زنی بر صفات مورد مطالعه گل جالیز مصری (*O.aegyptiaca*) (اعداد میانگین مربعات می باشد).

منابع تغییر	درجه آزادی	G%	R ₅₀	GU	D ₁₀	D ₅₀	D ₉₀
درجه حرارت (A)	۵	۱۶۷۸۶**	۰/۰۰۰۹۴**	۱۹۷۲/۹**	۱۰۷۱۳۹**	۱۰۹۲۵۷**	۱۰۳۰۶۵**
پتانسیل اسمزی (B)	۴	۲۹۰۹**	۰/۰۰۰۰۷**	۲۵۴/۳ ^{ns}	۲۳۶۴/۶**	۱۸۸۱/۵**	۴۰۷۸/۴**
A*B	۲۰	۵۵۹/۷**	۰/۰۰۰۰۰۶**	۱۲۴۷/۳**	۱۲۸/۵ ^{ns}	۸۶/۰۵ ^{ns}	۸۹۱/۸**
خطا	۹۰	۵۸/۴	۰/۰۰۰۰۰۱۷	۱۸۳/۵	۱۴۲/۹	۱۵۷/۸	۳۱۸
کل	۱۱۹	۹۴۱	۰/۰۰۰۰۴۴	۴۳۹/۸	۴۷۱۰/۸	۴۷۸۷/۷	۴۸۵۷/۹

(G%): درصد جوانه زنی نهایی، R₅₀: سرعت جوانه زنی، GU: یکنواختی جوانه زنی، D₁₀، D₅₀، D₉₀ به ترتیب زمان تا رسیدن به ۱۰، ۵۰ و ۹۰ درصد جوانه زنی) و ^{**} و ^{ns} به ترتیب معنی داری در سطح ۰/۰۱ و عدم معنی داری می باشند.

جدول ۲- ضرایب مدل دوزنقه‌ای و دوتکه برآزش داده شده به درصد و سرعت جوانه زنی بذور گل جالیز مصری (*O.aegyptiaca*).

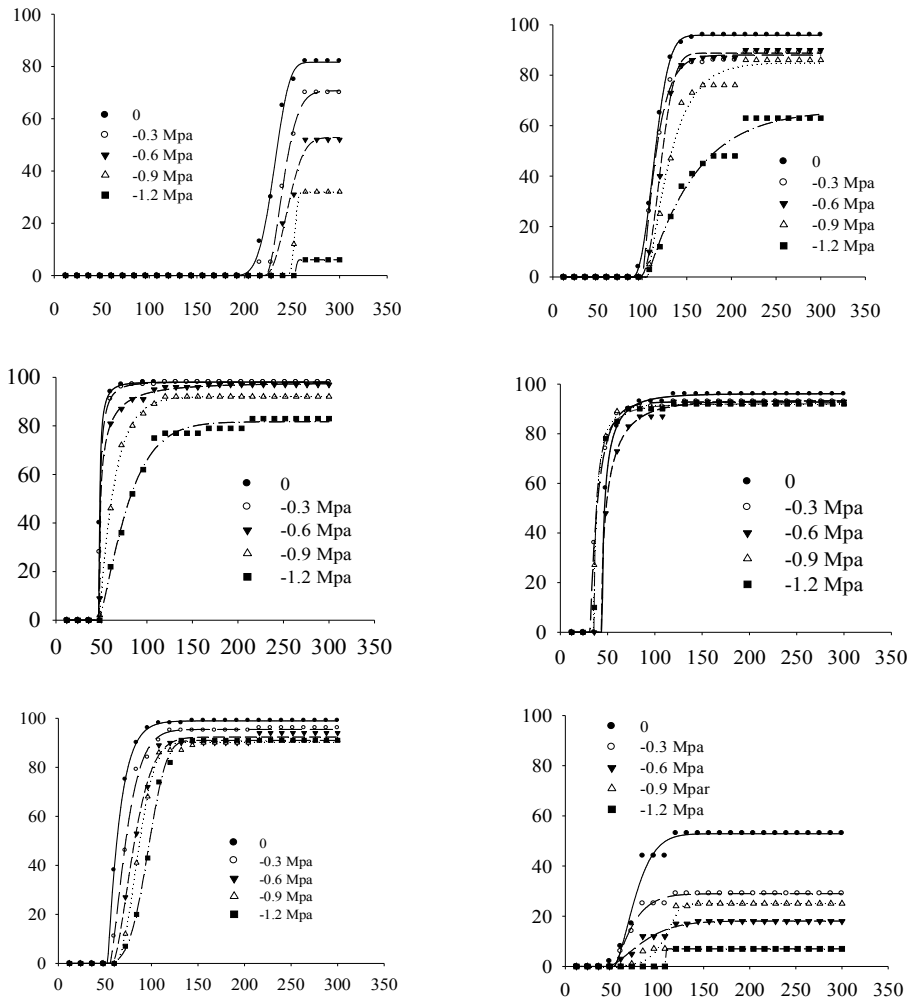
درصد جوانه زنی (/.)				
	-۰/۳	-۰/۶	-۰/۹	-۱/۲
	مگا پاسکال	مگا پاسکال	مگا پاسکال	مگا پاسکال
دمای پایه	۳/۸	۴/۰	۴/۷	۶/۴
دمای مطلوب ۱	۱۴/۰	۱۴/۴	۱۴/۹	۱۹/۷
دمای مطلوب ۲	۳۰/۰	۲۹/۰	۲۸/۷	۲۸/۹
دمای حداکثر	۴۰/۲	۳۹/۴	۳۸/۹	۳۸/۶
سرعت جوانه زنی (ساعت / ۱)				
	-۰/۳	-۰/۶	-۰/۹	-۱/۲
	مگا پاسکال	مگا پاسکال	مگا پاسکال	مگا پاسکال
دمای پایه	۵/۶	۵/۶	۵/۶	۵/۵
دمای مطلوب	۳۰/۱	۳۰/۱	۳۰/۱	۳۰/۲
دمای حداکثر	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰

مقایسه میانگین بین تیمارها نشان داد که دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد با ۹۴/۲ درصد و دمای ۳۵ درجه سانتی‌گراد با ۲۶/۴ درصد به ترتیب بیشترین و کمترین درصد جوانه‌زنی نهایی را داشتند (شکل ۳). درصد جوانه‌زنی در دماهای ۲۰، ۲۵ و ۳۰ درجه سانتی‌گراد با هم اختلاف آماری نداشتند؛ ولی با دیگر دماها اختلافات معنی‌دار بود ($P \leq 0/01$). افزایش دما تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد موجب افزایش درصد جوانه‌زنی نهایی شد و بعد از آن تقریباً ثابت ماند. دماهای پس از ۳۰ درجه سانتی‌گراد به شدت درصد جوانه‌زنی نهایی را کاهش داد. به طوری که در دمای ۳۵ درجه سانتی‌گراد به حداقل خود رسید. گو و الخطیب (Guo and Al-Khatib, 2003) نیز بیان کردند که درصد جوانه‌زنی با افزایش دما تا دمای مطلوب افزایش و بعد از آن کاهش می‌یابد. نکته قابل توجه حساسیت بذور گل‌جالیز مصری به گرما نسبت به سرما بود؛ زیرا در دمای ۳۵ درجه سانتی‌گراد شدت کاهش درصد جوانه‌زنی نهایی بیشتر از دمای ۱۰ درجه سانتی‌گراد بود که احتمالاً به دلیل خواب ثانویه یا مرگ بذور در این دما باشد. درصد جوانه‌زنی نهایی بذور با کاهش پتانسیل اسمزی به صورت خطی کاهش یافت. به طوری که با ۸۷ درصد جوانه‌زنی در شاهد به ۵۷ درصد جوانه‌زنی در پتانسیل اسمزی ۱/۲- مگاپاسکال رسید. درصد جوانه‌زنی نهایی در پتانسیل‌های اسمزی ۰/۶- و ۰/۹- مگاپاسکال با هم تفاوت آماری نداشتند؛ ولی در مقایسه با دیگر پتانسیل‌های اسمزی، اختلاف معنی‌دار بود ($P \leq 0/01$) (شکل ۴). کمترین و بیشترین درصد جوانه‌زنی نهایی به ترتیب از پتانسیل اسمزی ۱/۲- مگاپاسکال با دمای ۱۰ درجه سانتی‌گراد و شاهد با دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد به دست آمد. درصد جوانه‌زنی در دماهای ۱۰ و ۳۵ درجه سانتی‌گراد با کاهش پتانسیل اسمزی به شدت کاهش یافت. در دیگر دماها به خصوص دماهای ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد روند کاهشی خیلی کند بود. اختلاف حداقل و حداکثر درصد جوانه‌زنی در دماهای ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد بین شاهد و پتانسیل اسمزی ۱/۲- مگاپاسکال به ترتیب ۷۵/۶، ۲۹/۶، ۸، ۱۶/۳، ۴/۳ و ۴۶ درصد بود. این نتایج نشان داد که در صورت کافی بودن آب، جوانه‌زنی در دمای زیرحد مطلوب از دمای بالای حد مطلوب بیشتر است. به عبارت دیگر، بذور گل‌جالیز در هوای خنک‌تر بهتر از هوای گرم‌تر جوانه می‌زند. همچنین اثر کاهشی تنش خشکی در دماهای زیر دمای مطلوب بیشتر از دماهای بالای دمای مطلوب است. کبری‌آب و موردوخ (Kebreab and Murdoch, 2000) نیز گزارش کردند که حداکثر جوانه‌زنی در پتانسیل‌های اسمزی مختلف با افزایش درجه حرارت تا دمای بهینه جوانه‌زنی افزایش یافت و یک‌باره بعد از دمای بهینه کاهش یافت.

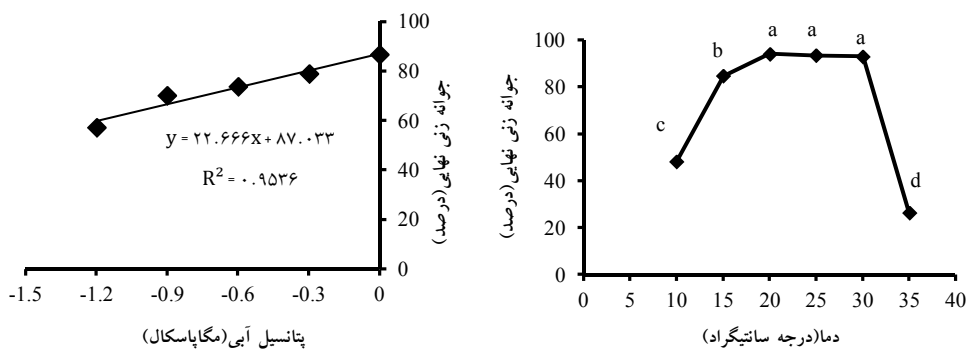
جدول ۳- برهم کنش دما و پتانسیل اسمزی بر صفات مورد مطالعه گل جالیز مصری (*O.aegyptiaca*)، (درصد جوانه زنی \pm خطای استاندارد (SE))

دما	پتانسیل اسمزی	G%	R ₅₀ (ساعت/۱)	GU(ساعت)	D ₁₀ (ساعت)	D ₅₀ (ساعت)	D ₉₀ (ساعت)
	۰	۸۲±۴/۲	۰/۰۰۴۳±۰/۰۰۰۰۰۲۹	۳۴/۵±۳/۰۳	۲۱۳±۲/۰۵	۲۳۱±۱/۵۸	۲۴۷±۳/۷
	-۰/۳	۷۰±۵/۰	۰/۰۰۴۱±۰/۰۰۰۰۰۴۷	۳۵/۱±۴/۶۲	۲۲۱±۵/۵۳	۲۴۱±۲/۷	۲۵۶±۳/۰۱
۱۰	-۰/۶	۵۲±۴/۹	۰/۰۰۴۱±۰/۰۰۰۰۰۳۳	۲۹/۵±۰/۶۹۱	۲۳۱±۰/۵۳۹	۲۴۴±۲/۰	۲۶۰±۰/۴۳۷
	-۰/۹	۳۲±۴/۹	۰/۰۰۳۹±۰/۰۰۰۰۰۱۸	۱۸/۷۰±/۲۲۰	۲۴۳±۰/۴۵۷	۲۵۳±۱/۱۶	۲۶۱±۰/۲۵۷
	-۱/۲	۶±۱/۱	۰/۰۰۳۸±۰	۹/۶±۰	۲۵۳±۰	۲۵۸±۰	۲۶۲±۰
	۰	۹۶±۱/۶	۰/۰۰۸۷±۰/۰۰۰۱۲۶	۳۴/۵±۲/۰۳	۹۹±۱/۱۲	۱۱۴±۱/۶۸	۱۱۳±۲/۱
	-۰/۳	۸۹±۱/۹	۰/۰۰۸۶±۰/۰۰۰۰۲۰۹	۴۲/۱±۱۱/۳۲	۱۰۰±۰/۸۹۲	۱۱۶±۲/۸۳	۱۴۲±۱۲/۲
۱۵	-۰/۶	۹۰±۳/۸	۰/۰۰۸۲±۰/۰۰۰۱۳۱	۳۱/۸±۲/۷۷	۱۰۶±۱/۵۹	۱۲۱±۱/۹۸	۱۳۸±۴/۳
	-۰/۹	۸۶±۴/۲	۰/۰۰۷۶±۰/۰۰۰۱۲۱	۷۱/۰±۱۷/۲۵	۱۱۰±۳/۴۴	۱۳۰±۱/۹۸	۱۸۱±۱۶/۱
	-۱/۲	۶۳±۶/۴	۰/۰۰۷۳±۰/۰۰۰۰۳۲۹	۹۲/۶±۳/۴۹	۱۱۷±۵/۰۷	۱۳۶±۵/۶۲	۲۱۰±۱/۷
	۰	۹۹±۱	۰/۰۱۵۶±۰/۰۰۰۲۰۲	۳۱/۷±۲/۴۳	۵۱±۰/۱۴۲	۶۳±۰/۸۱۹	۸۳±۲/۵
	-۰/۳	۹۶±۱/۶	۰/۰۱۳۷±۰/۰۰۰۴۸۴	۳۶/۴±۲/۹۳	۵۸±۲/۶۹	۷۲±۲/۵۴	۹۵±۵/۱
۲۰	-۰/۶	۹۴±۲/۶	۰/۰۱۲۲±۰/۰۰۰۲۵۲	۴۰/۷±۳/۹۸	۶۴±۰/۴۵۵	۸۱±۱/۶۸	۱۰۵±۴/۲
	-۰/۹	۹۱±۳/۸	۰/۰۱۱۵±۰/۰۰۰۴۲۷	۳۲/۴±۰/۷۹۷	۷۰±۳/۱۷	۸۶±۳/۱۵	۱۰۲±۳/۰
	-۱/۲	۹۱±۶/۴	۰/۰۱۰۵±۰/۰۰۰۶۵۴	۳۳/۶±۳/۷۲	۷۹±۵/۲۹	۹۶±۵/۳۳	۱۱۳±۶/۵
	۰	۹۸±۲	۰/۰۲۰۲±۰/۰۰۰۴۹۹	۱۹/۳±۰/۸۶۳	۳۹±۰/۸۷۷	۴۹±۱/۴۲	۵۸±۰/۳۱۳
	-۰/۳	۹۸±۲	۰/۰۱۹۲±۰/۰۰۰۲۵	۱۹/۸±۰/۶۶۲	۴۰±۰/۸۱۸	۵۱±۰/۶۷۶	۶۰±۱/۲
۲۵	-۰/۶	۹۷±۱	۰/۰۱۸۳±۰/۰۰۰۱۷۳	۲۸/۷±۹/۹۶	۴۷±۱/۷	۵۴±۰/۵۲۱	۷۵±۸/۴
	-۰/۹	۹۲±۲/۳	۰/۰۱۶۳±۰/۰۰۰۵۹۸	۴۱/۶±۸/۳۲	۵۰±۰/۳۷۴	۶۱±۲/۲۸	۹۱±۸/۵
	-۱/۲	۸۳±۸/۱	۰/۰۱۳۲±۰/۰۰۰۵۱	۶۶/۶±۱۴/۶۱	۵۲±۰/۳۹۹	۷۵±۲/۸۹	۱۱۹±۱۴/۶
	۰	۹۶±۱/۶	۰/۰۲۵۹±۰/۰۰۰۹۸۲	۲۲/۱±۳/۰۷	۲۷±۱/۱۵	۳۸±۱/۴۸	۵۲±۲/۴
	-۰/۳	۹۳±۳/۴	۰/۰۲۴۷±۰/۰۰۰۳۲۱	۲۳/۷±۲/۳۹	۲۸±۰/۳۰۶	۴۰±۰/۵۱۷	۵۷±۲/۵
۳۰	-۰/۶	۹۳±۱/۹	۰/۰۲۳۶±۰/۰۰۰۰۵۸	۳۰/۷±۲/۱۱	۳۴±۰/۷۹۸	۴۲±۰/۱۰	۵۸±۳/۱
	-۰/۹	۹۲±۱/۶	۰/۰۲۱۷±۰/۰۰۰۳۲۵	۳۵/۱±۵/۰	۳۸±۰/۱۳۸	۴۶±۰/۶۹۰	۷۳±۵/۲
	-۱/۲	۹۲±۱/۶	۰/۰۲۰۸±۰/۰۰۰۷۳	۳۶/۲±۱۲/۱۲	۳۸±۰/۳۹۰	۴۸±۱/۷۸	۷۴±۱۲/۲
	۰	۵۳±۶/۶	۰/۰۱۳۱±۰/۰۰۰۱۷۴	۴۹/۸±۹/۷	۵۵±۳/۸۸	۷۶±۱/۰۲	۱۰۵±۷/۹
	-۰/۳	۲۹±۵	۰/۰۱۴۰±۰/۰۰۰۴۹۵	۴۲/۲±۸/۳۳	۵۵±۳/۰	۷۱±۲/۵۶	۹۸±۹/۹
۳۵	-۰/۶	۱۸±۲	۰/۰۱۲۶±۰/۰۰۱۶۳	۵۱/۹±۷/۷	۶۰±۶/۰۲	۸۳±۱۱/۳۲	۱۱۳±۱۱/۸
	-۰/۹	۲۵±۴/۱	۰/۰۱۰۶±۰/۰۰۱۰۹	۲۶±۶/۸	۸۹±۱۱/۶۶	۹۷±۹/۹۷	۱۱۵±۸/۹
	-۱/۲	۷±۳	۰/۰۰۶۵±۰/۰۰۲۱۹	۷/۲±۲/۴	۸۲±۲۷/۳	۸۵±۲۸/۵	۸۹±۲۹/۷

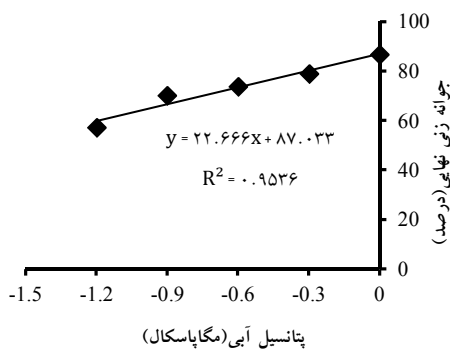
G%: درصد جوانه زنی نهایی، R₅₀: سرعت جوانه زنی، GU: یکنواختی جوانه زنی، D₁₀، D₅₀، D₉₀ به ترتیب زمان تا رسیدن به ۱۰، ۵۰ و ۹۰ درصد جوانه زنی)



شکل ۲- روند درصد جوانه زنی تجمعی بذور گل جالیز مصری (*O. aegyptiaca*) در پتانسیل های اسمزی مختلف (۰، ۰/۳، ۰/۶، ۰/۹، ۱/۲- مگاپاسکال) در دمای ۱۰ (الف)، ۱۵ (ب)، ۲۰ (ج)، ۲۵ (د)، ۳۰ (چ) و ۳۵ (و) درجه سانتیگراد. نقاط داده های آزمایش و خطوط مدل ویبول ۴ پارمتری برازش داده شده است.



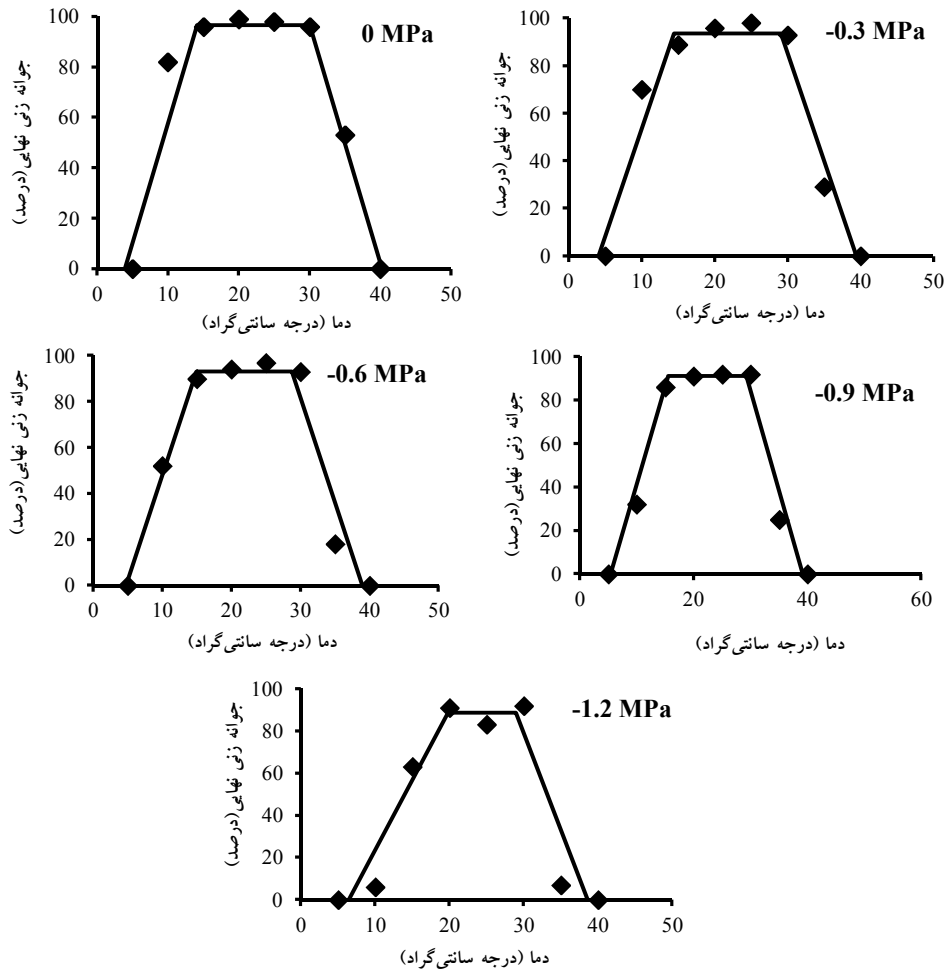
شکل ۳- اثر دماهای مختلف جوانه زنی (۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰ و ۳۵ درجه سانتیگراد) بر جوانه زنی نهایی بذور گل جالیز مصری (*O. aegyptiaca*) (نقاط با حروف مشترک بر اساس آزمون LSD در سطح ۰/۰۱ اختلاف معنی دار ندارند)



شکل ۴- اثر پتانسیل های اسمزی (۰، ۰/۳، ۰/۶، ۰/۹، ۱/۲ و ۱/۲- مگاپاسکال) بر جوانه زنی نهایی بذور گل جالیز مصری (*O. aegyptiaca*)

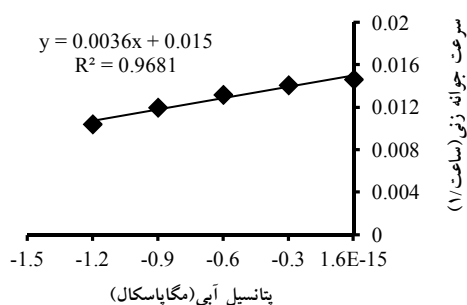
روند تغییرات درصد جوانه زنی نهایی در دماهای مختلف از یک مدل دوزنقه ای پیروی کرد که با برآزش این مدل بر درصد جوانه زنی نهایی در پتانسیل های اسمزی مختلف دمای حداقل، حداکثر و مطلوب برای درصد جوانه زنی نهایی به ترتیب برای پتانسیل های اسمزی مختلف به دست آمد. کاهش پتانسیل اسمزی موجب کاهش حداکثر جوانه زنی و همچنین کاهش دامنه دمای مطلوب جوانه زنی گردید (شکل ۵). دمای مطلوب برای حداکثر درصد جوانه زنی برای پتانسیل های اسمزی صفر تا ۱/۲- مگاپاسکال به ترتیب ۳۰-۱۴، ۲۹-۱۴/۴، ۲۸/۷-۱۴/۹، ۲۹/۲-۱۵/۵ و ۲۸/۹-۱۹/۷ درجه سانتیگراد بود. کاهش پتانسیل اسمزی علاوه بر کاهش حداکثر جوانه زنی دامنه دمای مطلوب را نیز کاهش داد (جدول ۲). کبری آب و موردوخ (Kebreab and Murdoch, 2000) بیان کردند پتانسیل اسمزی بر دامنه حرارتی که حداکثر جوانه زنی در آن رخ می دهد، تأثیر گذار است به طوری که در پتانسیل اسمزی صفر مگاپاسکال حداکثر درصد جوانه زنی در دامنه دمایی ۱۷ تا ۲۶ درجه سانتیگراد به دست آمد (با دامنه ۹ درجه سانتیگراد). در حالی که در پتانسیل اسمزی ۱/۲۵- مگاپاسکال در دامنه ۱۷ تا ۲۰ درجه سانتیگراد بود (با دامنه ۳ درجه سانتیگراد). دمای مطلوب جوانه زنی نیز با کاهش پتانسیل اسمزی کاهش یافت. کاهش پتانسیل اسمزی بر دمای شروع و دمای حداکثر جوانه زنی تأثیر گذار بود و موجب کاهش دامنه دمایی جوانه زنی بذور گل جالیز مصری شد. کبری آب و موردوخ (Kebreab and Murdoch, 2000) بیان کردند که پتانسیل اسمزی و درجه حرارت هر دو بر درصد جوانه زنی نهایی بذور تأثیر گذارند. گزارش شده است که درصد نهایی جوانه زنی بذور گل جالیز مصری در پتانسیل های

اسمزی بالا (شاهد، $-0/2$ و $-0/6$ مگاپاسکال) در دماهای بین ۱۴ تا ۲۶ درجه سانتی‌گراد به ۱۰۰ درصد رسید. دمای مطلوب برای حداکثر جوانه‌زنی با کاهش پتانسیل اسمزی کاهش یافت.

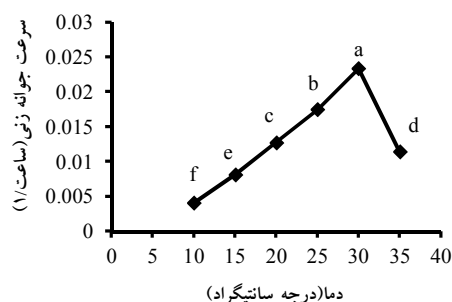


شکل ۵- درصد جوانه‌زنی نهایی بذور گل‌جالیز مصری (*O.aegyptiaca*) در مقابل دماهای مختلف جوانه‌زنی (۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰ و ۳۵ درجه سانتی‌گراد) برای پتانسیل‌های اسمزی ۰، $-0/3$ ، $-0/6$ ، $-0/9$ و $-1/2$ مگاپاسکال. نقاط داده‌های آزمایش و خطوط مدل دوزنقه‌ای برازش داده شده.

برای مثال، دمای مطلوب در صفر مگاپاسکال ۲۶ درجه سانتی‌گراد بود. در حالی که در ۱/۲۵- مگاپاسکال به ۲۰ درجه سانتی‌گراد رسید. در دماهای بالاتر از دمای مطلوب، بذور با کاهش پتانسیل‌های اسمزی آستانه درجه‌حرارت پایین تری برای جوانه‌زنی داشتند. برای مثال، در دمای ۳۲ درجه سانتی‌گراد بیشتر از ۶۰ درصد بذور در پتانسیل اسمزی صفر مگاپاسکال جوانه زدند، در حالی که در دمای ۲۶ درجه سانتی‌گراد و پتانسیل اسمزی ۱/۲۸- مگاپاسکال جوانه‌زنی محسوسی رخ نداد. آنها به نقل از لینک (Link, 1987) که گزارش کرد که جوانه‌زنی نهایی بذور *O.ramosa* با کاهش پتانسیل اسمزی کاهش یافت و درصد جوانه‌زنی نهایی در شاهد تا ۰/۲- مگاپاسکال پتانسیل اسمزی در دمای بین ۱۹ تا ۲۳ درجه سانتی‌گراد بین ۹۰ تا ۷۰ درصد بود، بیان کردند که دلیل تفاوت در نتایج این مطالعات می‌تواند حساس‌تر بودن بذور *O.ramosa* به تنش آب باشد. کبری‌آب و موردوخ (Kebreab and Murdoch, 1999b) نشان دادند که پتانسیل پایه اسمزی بذور گل جالیز مصری در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد ۱/۹۶- مگاپاسکال است. وقتی که درجه حرارت تا ۸ درجه کاهش یافت یا تا دمای ۲۹ درجه سانتی‌گراد افزایش یافت، پتانسیل پایه اسمزی به ترتیب ۱/۳۴- و ۱/۵۱- مگاپاسکال افزایش یافت.



شکل ۷- اثر پتانسیل‌های اسمزی (۰، ۰/۳، ۰/۶، ۰/۹، ۱/۲- مگاپاسکال) بر سرعت جوانه‌زنی بذور گل جالیز مصری (*O.aegyptiaca*).

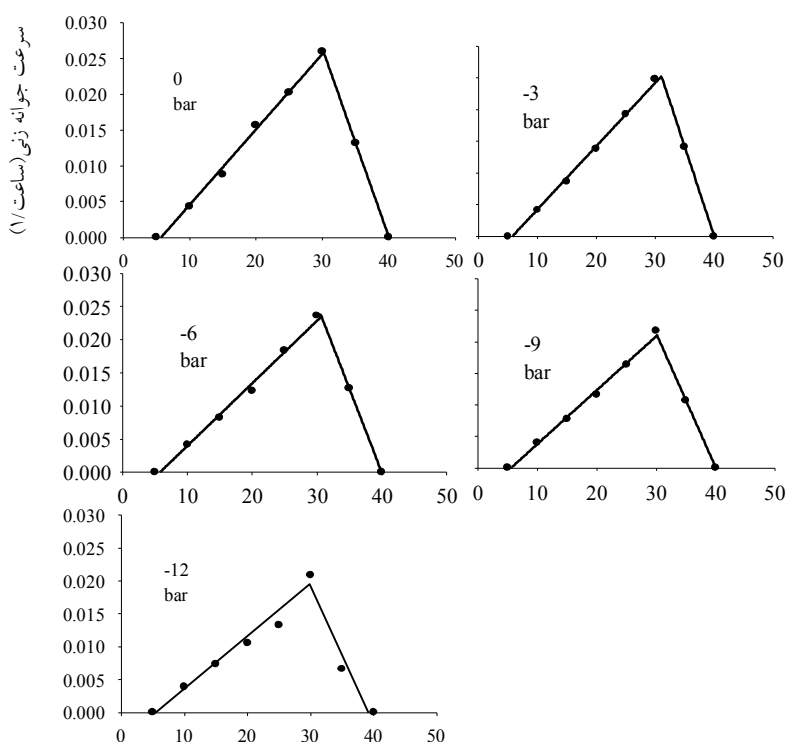


شکل ۶- اثر دماهای مختلف جوانه‌زنی (۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰ و ۳۵ درجه سانتی‌گراد) بر سرعت جوانه‌زنی بذور گل جالیز مصری (*O.aegyptiaca*).

سرعت جوانه‌زنی: بررسی سرعت جوانه‌زنی بذور نشان داد که اثر دما، پتانسیل اسمزی و برهم‌کنش آنها بر این صفت معنی‌دار بود ($P \leq 0.01$) (جدول ۱). مقایسه میانگین اثر دما بر سرعت جوانه‌زنی نشان داد که دمای ۳۰ درجه سانتی‌گراد با ۰/۰۲۳۴ (۱/ساعت) بیشترین و دمای ۱۰ درجه سانتی‌گراد با ۰/۰۰۴۰ (۱ ساعت) کمترین سرعت جوانه‌زنی را داشتند (شکل ۶). تمامی دماها در این صفت با هم

اختلاف معنی‌داری داشتند ($P \leq 0/01$). سرعت جوانه‌زنی یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی تحمل به خشکی در مرحله جوانه‌زنی است و هرچه سرعت جوانه‌زنی بیشتر باشد، شانس رویش بذر تحت شرایط تنش، بیشتر خواهد شد (Fernandez and Johnston, 1995). نوسانات سرعت جوانه‌زنی بذور در دماهای مختلف، ناشی از عکس‌العمل متفاوت آنها به گرما دانسته شده است. در دماهای خیلی پایین، پروتئین و آنزیم‌ها برای تطابق با تغییرات مورد نیاز جهت واکنش به مقدار کافی انعطاف‌پذیر نیستند؛ ولی با افزایش دما فعالیت آنزیم‌ها افزایش می‌یابد و در نتیجه سرعت جوانه‌زنی نیز بالا می‌رود. از طرفی دماهای خیلی بالا نیز باعث غیر فعال شدن برخی آنزیم‌ها می‌شوند؛ لذا سرعت واکنش‌ها کاهش می‌یابد. به همین دلیل، جوانه‌زنی به درجه حرارت، عکس‌العمل کمینه، بهینه و بیشینه دارد (Bonhomme, 2000). در مقایسه میانگین اثر پتانسیل اسمزی بر سرعت جوانه‌زنی مشخص شد که با کاهش پتانسیل اسمزی سرعت جوانه‌زنی کاهش یافت. پتانسیل اسمزی صفر و $0/3$ - مگاپاسکال با هم اختلاف آماری نداشتند ولی این دو پتانسیل اسمزی با 3 پتانسیل دیگر اختلاف معنی‌دار داشتند ($P \leq 0/01$) (شکل ۷). در بررسی برهم‌کنش دما و پتانسیل اسمزی بر سرعت جوانه‌زنی مشخص شد که با کاهش پتانسیل اسمزی در همه دماها سرعت جوانه‌زنی کاهش می‌یابد. به‌جز دماهای 20 و 35 درجه سانتی‌گراد که در پتانسیل‌های اسمزی $0/3$ ، $0/6$ و $0/9$ - با هم تفاوت آماری نداشتند، همه تیمارها دارای اختلاف معنی‌دار بودند ($P \leq 0/01$). سرعت جوانه‌زنی در دماهای 30 ، 25 ، 20 ، 35 ، 15 و 10 درجه سانتی‌گراد در تمامی پتانسیل‌های اسمزی به‌ترتیب دارای بیشترین تا کمترین مقدار بود. به سخن دیگر، در همه پتانسیل‌های اسمزی سرعت جوانه‌زنی دمای 30 درجه سانتی‌گراد از سایر دماها بیشتر بود و در دمای 10 درجه سانتی‌گراد نیز در همه پتانسیل‌های اسمزی کمترین سرعت جوانه‌زنی به دست آمد (جدول ۳). با برآزش مدل دو تکه به داده‌های سرعت جوانه‌زنی بذور گل‌جالیز مصری در شاهد دمای حداقل، مطلوب و حداکثر جوانه‌زنی به‌دست آمد که به‌ترتیب $5/6$ ، $30/1$ و 40 درجه سانتی‌گراد بودند. این مدل بر سرعت جوانه‌زنی در پتانسیل‌های اسمزی $0/3$ ، $0/6$ ، $0/9$ - و $1/2$ - مگاپاسکال نیز برآزش داده شد که دمای حداقل، مطلوب و حداکثر سرعت جوانه‌زنی را در همین محدوده دمایی شاهد برآورد نمود (شکل ۸ و جدول ۲). بدین ترتیب می‌توان بیان کرد که با وجود کاهش سرعت جوانه‌زنی در پتانسیل‌های اسمزی مختلف نسبت به شاهد، محدوده دمای جوانه‌زنی و دمای مطلوب برای سرعت جوانه‌زنی در تمامی پتانسیل‌های اسمزی تقریباً مشابه بود. با کاهش پتانسیل اسمزی، دامنه دمایی برای سرعت جوانه‌زنی تغییر نکرد، در صورتی که برای درصد جوانه‌زنی این دامنه دمایی کمتر شد. به‌طور مثال، دامنه دمایی درصد جوانه‌زنی در پتانسیل اسمزی 0 و $1/2$ - مگاپاسکال به‌ترتیب $36/4$ و $32/2$ درجه سانتی‌گراد بود؛ یعنی با کاهش پتانسیل اسمزی، دامنه دمایی

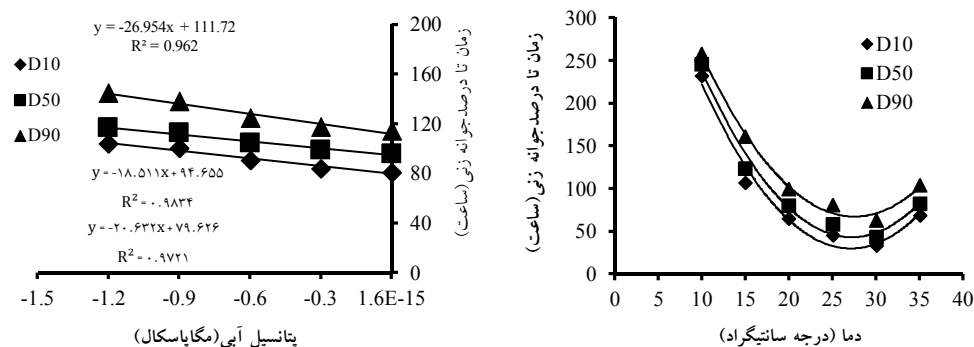
جوانه زنی کاهش یافت. در حالی که دامنه دمایی برای سرعت جوانه زنی در هر دو پتانسیل اسمزی ۳۴ درجه سانتی گراد بود. همچنین حداکثر سرعت جوانه زنی در یک نقطه دمایی صورت گرفت. در حالی که حداکثر درصد جوانه زنی در یک دامنه دمایی مشاهده شد (شکل های ۸ و ۵).



شکل ۸- برازش مدل دو تکه بر سرعت جوانه زنی بذور گل جالیز مصری (*O.aegyptiaca*) در پتانسیل های اسمزی مختلف (۰، -۰/۳، -۰/۶، -۰/۹ و -۱/۲ مگاپاسکال).

زمان تا ۱۰، ۵۰ و ۹۰ درصد جوانه زنی: دما و پتانسیل اسمزی اثرات معنی داری بر زمان تا ۱۰، ۵۰ و ۹۰ درصد جوانه زنی داشتند، ولی برهم کنش آنها بر زمان تا ۱۰ و ۵۰ درصد جوانه زنی معنی دار نبوده و فقط زمان تا ۹۰ درصد جوانه زنی تحت تأثیر برهم کنش دما و پتانسیل اسمزی قرار گرفت ($P \leq 0.01$) (جدول ۱). مقایسه میانگین اثر دما بر ۱۰، ۵۰ و ۹۰ درصد جوانه زنی نشان داد که با افزایش دما تا ۳۰ درجه سانتی گراد زمان تا این برخه های جوانه زنی کاهش و بعد از آن افزایش می یابد. روند تغییرات این برخه ها از مدل درجه ۲ پیروی کرد. مقادیر این صفات در تمامی دماهای مورد بررسی این مطالعه با هم تفاوت

آماري داشتند ($P \leq 0/01$) (شکل ۹). جامی‌الاحمدی و کافی (Jami Al-Ahmadi and Kafi, 2007) بیان کردند که بین زمان مورد نیاز برای رسیدن به یک میزان مشخص جوانه زنی (مثلاً ۲۰ یا ۵۰ درصد) و درجه حرارت رابطه معکوس وجود دارد.



شکل ۹- اثر دماهای مختلف جوانه زنی (۱۰، ۲۰، ۲۵، ۳۰ و ۳۵ درجه سانتیگراد) بر زمان تا ۱۰، ۵۰ و ۹۰ درصد جوانه زنی بذور گل‌جالیز مصری (*O.aegyptiaca*).
 شکل ۱۰- اثر پتانسیل‌های اسمزی (۰، ۰/۳، ۰/۶، ۰/۹، ۱/۲ و ۱/۳- مگاپاسکال) بر زمان تا ۱۰، ۵۰ و ۹۰ درصد جوانه زنی بذور گل‌جالیز مصری (*O.aegyptiaca*)

مقایسه میانگین اثر پتانسیل اسمزی بر زمان تا ۱۰، ۵۰ و ۹۰ درصد جوانه‌زنی نشان داد که کاهش پتانسیل اسمزی موجب افزایش زمان تا این برخه‌ها شد. اختلاف زمان تا ۹۰ درصد جوانه‌زنی بین شاهد و پتانسیل اسمزی ۱/۲- مگاپاسکال حدود ۳۰ ساعت بود. در حالی که اختلاف زمان تا ۱۰ و ۵۰ درصد جوانه‌زنی به ترتیب به ۲۲ و ۲۱ ساعت رسید. اختلاف معنی‌داری در زمان رسیدن به ۱۰، ۵۰ و ۹۰ درصد جوانه‌زنی در تیمارهای شاهد با ۰/۳- مگاپاسکال، ۰/۳- با ۰/۶- مگاپاسکال و ۰/۹- با ۱/۲- مگاپاسکال وجود نداشت ($P \leq 0/01$) (شکل ۱۰). در بررسی مقایسه میانگین برهم‌کنش دما و پتانسیل اسمزی مشخص شد که فقط زمان تا ۹۰ درصد جوانه‌زنی تحت تأثیر قرار گرفت. روند تغییرات بدین‌گونه بود که با کاهش پتانسیل اسمزی در هر دمایی، زمان تا ۹۰ درصد جوانه‌زنی افزایش یافت. در تمامی پتانسیل‌های اسمزی با نزدیک شدن به دمای بهینه جوانه‌زنی (۲۰ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد) زمان تا ۹۰ درصد جوانه‌زنی کاهش یافت. برای مثال، زمان تا ۹۰ درصد جوانه‌زنی در دمای ۱۰ درجه سانتی‌گراد برای پتانسیل‌های اسمزی صفر تا ۱/۲- مگاپاسکال به ترتیب ۲۴۷، ۲۵۶، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲ ساعت بود؛ ولی زمان تا این برخه برای پتانسیل‌های اسمزی مذکور در دمای ۳۰ درجه سانتی‌گراد به ترتیب ۵۸، ۵۱، ۵۶، ۷۴ و ۷۳ ساعت بود (جدول ۳). در مجموع، می‌توان بیان کرد که اثر دما نسبت به پتانسیل اسمزی بر زمان تا ۱۰، ۵۰ و ۹۰ درصد جوانه‌زنی بیشتر بود. کاهش پتانسیل اسمزی موجب

تأخیر در شروع، متوسط و حداکثر جوانه‌زنی بذور گل‌جالیز شد؛ ولی با نزدیک شدن به محدوده دمای بهینه زمان تا ۱۰، ۵۰ و ۹۰ درصد جوانه‌زنی کاهش یافت. قنبری و همکاران (Ghanbari et al., 2005) بیان کردند که طول دوره جوانه‌زنی یعنی فاصله بین شروع و پایان جوانه‌زنی، عامل تعیین‌کننده‌ای در واکنش جوانه زنی به عوامل محیطی مختلف می‌باشد. بنابراین اختلاف زمان رسیدن به ۱۰، ۵۰ و ۹۰ درصد جوانه‌زنی می‌تواند معیاری از طول دوره جوانه‌زنی باشد که تحت تأثیر شرایط حاکم بر جوانه‌زنی خصوصاً دما و پتانسیل اسمزی قرار می‌گیرد.

نتایج این مطالعه نشان داد که بذور گل‌جالیز در دماهای ۲۰ و ۳۵ درجه سانتی‌گراد به ترتیب با ۹۴/۲ و ۲۶/۴ درصد جوانه‌زنی بیشترین و کمترین درصد جوانه‌زنی را داشتند. کاهش پتانسیل اسمزی موجب تأخیر در شروع، متوسط و حداکثر جوانه‌زنی بذور گل‌جالیز مصری شد. در صورت وجود تنش خشکی بیشترین و کمترین درصد جوانه‌زنی به ترتیب در شاهد با ۸۷ درصد جوانه‌زنی و پتانسیل اسمزی ۱/۲- مگاپاسکال با ۵۷ درصد جوانه‌زنی به دست آمد. دامنه دمای مطلوب جوانه‌زنی نیز با کاهش پتانسیل آبی کاهش یافت. در برهم‌کنش دما و پتانسیل اسمزی بر درصد جوانه‌زنی نهایی کمترین و بیشترین درصد جوانه‌زنی نهایی به ترتیب در پتانسیل اسمزی ۱/۲- مگاپاسکال با دمای ۱۰ درجه سانتی‌گراد و شاهد با دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد به دست آمد. با کاهش پتانسیل آب سرعت جوانه‌زنی بذور کاهش یافت. در تمامی پتانسیل‌های اسمزی، دمای ۳۰ و ۱۰ درجه سانتی‌گراد به ترتیب بیشترین و کمترین سرعت جوانه‌زنی را داشتند. مدل دو تکه برازش داده شده بر سرعت جوانه‌زنی بذور گل‌جالیز دماهای حداقل، مطلوب و حداکثر جوانه‌زنی را به ترتیب ۵/۶، ۳۰/۱ و ۴۰ درجه سانتی‌گراد برآورد کرد.

منابع

- Abnous M. 2001. Ecophysiological effects of drought stress on germination and seedling stages of lentil cultivars. Master's thesis. Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad. (In Farsi)
- Baghestani M.A., Jamnejad M., Minbashi M., Maighani F. 2010. Study the effects of temperature and GR₆₀ concentration on seed germination of two broomrape (*Orobanche aegyptiaca* and *O.cernua*) species and their growth in presence of tomato and tobacco. Journal of Crops Improvement, 12(2): 11-23. (In Farsi)
- Behdani M.A., Koocheki A., Nassiri M., Rezvani P. 2008. Models to predict flowering time in the main Saffron production regions of Khorasan province. Journal of Applied Sciences, 8: 907-909.
- Bonhomme R. 2000. Bases and limits to using degree day units. European Journal of Agronomy, 13: 1-10.
- Bradford K.J. 2002. Application of hydrithermal time to quantifying and modeling seed germination and dormancy. Weed Science, 50: 248-260.

- Eizenberg H., Tanaami Z., Jacobsohn R., Rubin B. 2001. Effect of temperature on the relationship between *Orobanche* spp. and carrot (*Daucus carota* L.). *Crop Protection*, 20:415–420.
- Fernandez G., Johnston M. 1995. Seed vigor testing in lentil, bean, and chickpea. *Seed Science and Technology*, 23: 617-627.
- Ghanbari A., Rahimiyan mashhadi H., Nassiri Mahalati M., Kafi M. Rastgoo M. 2005. Ecophysiological aspects of Liquorice (*Glycyrrhiza glabra* L.) germination under different temperatures. *Journal of Iranian Field Crop Research*, 3(2): 263-275. (In Farsi)
- Guo P., Al-Khatib K. 2003. Temperature effects on germination and growth of redroot pigweed (*Amaranthus retroflexus*), palmer amaranth (*A. palmeri*) and common waterhemp (*A. rudis*). *Weed Science*, 51: 869-875.
- Jami Al-Ahmadi M., Kafi M. 2007. Cardinal temperatures for germination of *Kochia scoparia*. *Journal of Arid Environments*, 68: 308-314.
- Johnson A.W., Gowda G., Wassanali A., Knox J., Monaco S., Razawi Z. Roseberry G. 1981. The preparation of synthetic analogues of strigol. *Journal of the Chemical Society (Perkin Transactions 1)*, 1:1734-1743.
- Kamkar B., Al-Alahmadi M.J., Mahdavi-Damghani A., Villalobos F.J. 2012. Quantification of the cardinal temperatures and thermal time requirement of opium poppy (*Papaver somniferum* L.) seeds to germinate using non-linear regression models. *Industrial Crops and Products*, 35: 192-198.
- Kebreab E., Murdoch A.J. 1999a. A quantitative model for loss of primary dormancy and induction of secondary dormancy in imbibed seeds of *Orobanche* spp. *Journal of Experimental Botany*, 50: 211–219.
- Kebreab E., Murdoch A.J. 1999b. Modelling the effects of water stress and temperature on germination rate of *Orobanche aegyptiaca* seeds. *Journal of Experimental Botany*, 50: 655–664.
- Kebreab E., Murdoch A.J. 2000. The effect of water stress on the temperature range for germination of *Orobanche aegyptiaca* seeds. *Seed Science Research*, 10: 127–133.
- Linke K.H. 1987. Untersuchungen über keimung und jugendentwicklung von Striga und *Orobanche*. PLITS5, 1–95. Hohenheim, Germany, Universität Hohenheim.
- Sauerborn J. 1991. Parasitic Flowering Plants: Ecology and Management. Weikersheim, Germany: Verlag Josef Margraf.
- Scott S.J., Jones R.A., Williams W.A. 1984. Review of data analysis methods for seed germination. *Crop Science*, 24: 1192-1199.
- Soltani A., Robertson M.J., Torabi B., Yousefi-Daz M., Sarparast R. 2006. Modelling seedling emergence in chickpea as influenced by temperature and sowing depth. *Agricultural and Forest Meteorology*, 138: 156-167.
- Vranceanu A.V., Pirvu N., Stoenescu F.M., Pacureanu M. 1986. Some aspects of the interaction *Helianthus annuus* L. *Orobanche Cumana* Wallr. and its implications in sunflower breeding. In: ter Borg SJ, eds. *Proceedings of the Workshop on Biology and Control of Orobanche*. Wageningen, The Netherlands: LH / VPO Wageningen, 181-189.